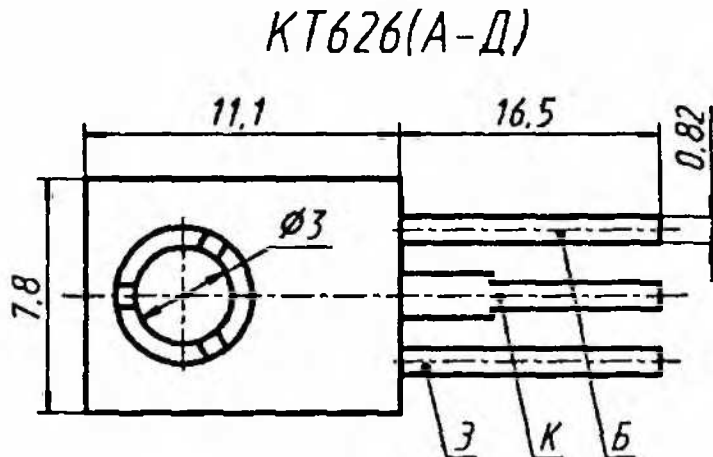


КТ626А, КТ626Б, КТ626В, КТ626Г, КТ626Д

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры $p-n-p$. Предназначены для применения в усилителях и генераторах коротковолнового диапазона и переключающих устройствах. Выпускаются в пластмассовом корпусе с жесткими выводами. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора не более 1 г.



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кэ} = 2$ В, $I_k = 0,15$ А:

$T = +25$ °С:

КТ626А, КТ626Д	40...250
КТ626Б	30...100
КТ626В	15...45
КТ626Г	15...60

$T = +85$ °С:

КТ626А, КТ626Д	40...500
КТ626Б	30...200
КТ626В	15...90
КТ626Г	15...120

$T = -40$ °С:

КТ626А, КТ626Д	20...250
КТ626Б	15...100
КТ626В	8...45
КТ626Г	8...60

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кэ} = 10$ В, $I_3 = 30$ мА, не менее:

КТ626А, КТ626Б	75 МГц
КТ626В, КТ626Г, КТ626Д	45 МГц
Напряжение насыщения коллектор—эмиттер КТ626А, КТ626Б при $I_K = 0,5$ А, $I_B = 0,05$ А и КТ626В, КТ626Г, КТ626Д при $I_K = 0,5$ А, $I_B = 0,1$ А, не более	1 В
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте при $U_{КБ0} = 10$ В, $I_B = 30$ мА, $f = 5$ МГц, не более	500 пс
Емкость коллекторного перехода при $U_{КБ0} = 10$ В, не более	150* пФ
Обратный ток коллектора, не более:	
КТ626А:	
при $U_{КБ0} = 30$ В	10 мкА
при $U_{КБ0} = 45$ В	1 мА
КТ626Б, КТ626В при $U_{КБ0} = 30$ В, КТ626Г, КТ626Д при $U_{КБ0} = 20$ В	150 мкА
КТ626Б при $U_{КБ0} = 60$ В и КТ626В при $U_{КБ0} = 80$ В	1 мА
Обратный ток эмиттера при $U_{ЭБ0} = 4$ В, не более:	
КТ626А	10 мкА
КТ626Б, КТ626В, КТ626Г, КТ626Д	300 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—база:	
КТ626А	45 В
КТ626Б	60 В
КТ626В	80 В
КТ626Г, КТ626Д	20 В
Постоянное напряжение коллектор—эмиттер при $R_{ЭБ} = 100$ Ом:	
КТ626А	45 В
КТ626Б	60 В
КТ626В	80 В
КТ626Г, КТ626Д	20 В
Постоянный ток коллектора	0,5 А
Импульсный ток коллектора	1,5 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллек- тора:	
при $T_K \leq +60$ °С	6,5 Вт
при $T_K = +85$ °С	4 Вт
Тепловое сопротивление переход—корпус	10 °С/Вт

Температура *p-n* перехода +125 °C
Температура окружающей среды -40... T_K =
= +85 °C

Изгиб выводов допускается не ближе 3 мм от корпуса транзистора с радиусом закругления 1,5...2 мм.

Пайка выводов допускается не ближе 5 мм от корпуса транзистора при температуре не выше +260 °C в течение не более 3 с.